

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

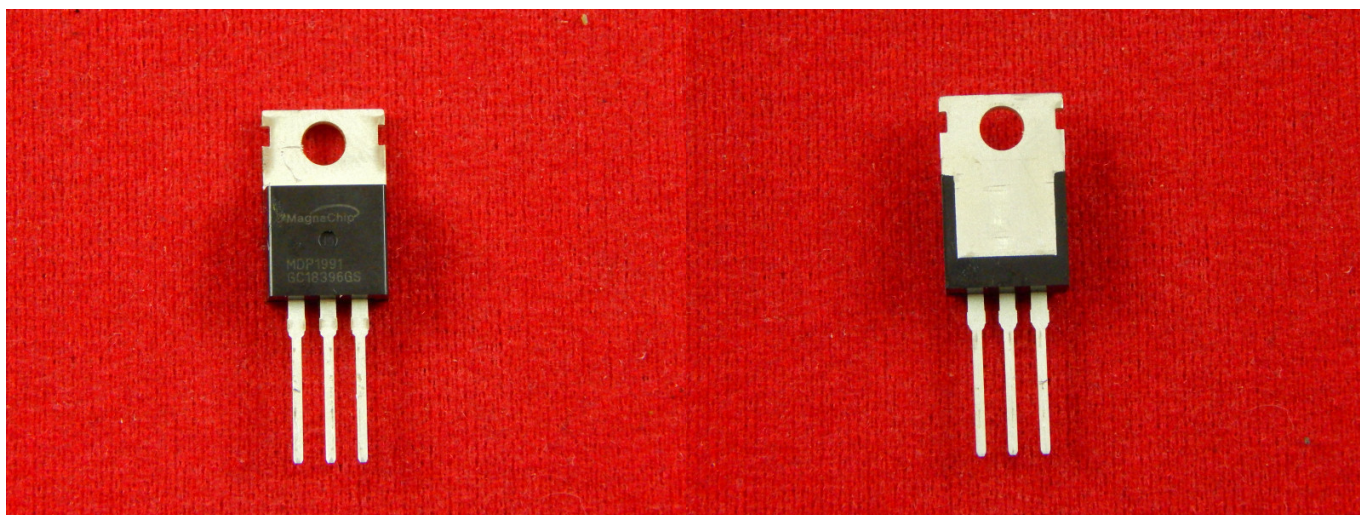
E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 17739**

**Цена в прайсе: 397 тг.**

**MDP1991, Транзистор N канальный, MOSFET, 120А, 100В, ТО-220**



Транзистор – полупроводниковый элемент с тремя выводами (обычно), на один из которых (коллектор) подаётся сильный ток, а на другой (база) подаётся слабый (управляющий ток).

Полевой транзистор — полупроводниковый прибор, принцип действия которого основан на управлении электрическим сопротивлением токопроводящего канала поперечным электрическим полем, создаваемым приложенным к затвору напряжением.

#### **Спецификация:**

- Наименование прибора: MDP1991;
- Тип транзистора: MOSFET;
- Полярность: N;
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 223 Вт;
- Предельно допустимое напряжение сток-исток  $|U_{ds}|$ : 100 В;
- Предельно допустимое напряжение затвор-исток  $|U_{gs}|$ : 20 В;
- Пороговое напряжение включения  $|U_{gs(th)}|$ : 4 В;
- Максимально допустимый постоянный ток стока  $|I_d|$ : 120 А;
- Максимальная температура канала (Tj): 150°C;
- Общий заряд затвора (Qg): 100 нС;
- Время нарастания (tr): 28.8 нс;
- Выходная емкость (Cd): 1300 пф;
- Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.0059 Ом;
- Тип корпуса: ТО-220.